7.14

(1)分别过用台半球面底面为知珠面的电场强度通量的一足,5—ES (OSTI = -TIR TE 半球底面为5, 中二分。 EIds= Ssz Ed(OSB = ESsz d(OSB = BRZ

(2) 粉球面内的总电荷量

多、E·ds=中、+中2=0 闭台半球面所国电荷的代数和为墨

7.18 电存储密度为PCKL

的某作定理有更E.ds=负Eds=EggdS=E.4加量长人PNU 离球心下处的电场强度为 E=1/4KELINDV= 4NELI 9= SupdV

半径 < K的高其后球面包围的电荷量

SUPOV= St Kr4T17dr = 4TK St 13dr = TKr4 得球体内的电场强度为 E=些

半径フR

S, PdV = So K+4TT+2d+=4TK SR+3J+=TKR4 得球体外的电场强度

E= KRT

7,22

和用為斯安理 $E_1 = \sqrt{\frac{3\zeta}{3\zeta}}e^{\frac{1}{3\zeta}}e^$ 在の気がっつ、ドラインでと、ここのをかりまるという。これのころできます。

to " Eo'= E101 = PC e = E0

PA为于两个线外 Ep'=Ep+Exp'= Pa3 e-103 e'= P (a3 - b3) P

P点为于大球内小球和电场强度

Ep=E,p+Erp= = pt - pb3 e'= p (rp- +12)e